## **ABSTRAK**

Penelitian yang dilakukan pada tugas akhir ini adalah mengamati sebaran lapisan dan mempelajari sifat listrik dari lapisan Tungsten Disulfida (WS<sub>2</sub>) yang dideposisi di atas berbagai substrat. 1 mg/mL WS<sub>2</sub> dimodifikasi dengan 2 mg/mL NaOH dan 10 mL NMP menggunakan metode eksfoliasi fasa cair. Warna dari larutan WS<sub>2</sub> dengan bertambahnya waktu sonikasi. Hal ini mengindikasikan proses eksfoliasi. Dari pengukuran transmisi, WS2 yang dieksfoliasi mengalami pergeseran dibandingkan dengan non eksfoliasi. WS<sub>2</sub> yang dieksfoliasi menyerap cahaya dengan dengan puncak serapan pada panjang gelombang 528 nm, sedangkan WS<sub>2</sub> non eksfoliasi menyerap cahaya dengan puncak serapan pada panjang gelombang 564 nm. Pergeseran panjang gelombang juga terlihat dari cahaya yang diemisikan. WS2 yang dieksfoliasi mengemisikan cahaya pada panjang gelombang 741 nm, sedangkan WS<sub>2</sub> non eksfoliasi mengemisikan cahaya pada panjang gelombang 880 nm. Larutan WS<sub>2</sub> yang telah dimodifikasi menyerap cahaya pada panjang gelombang 564 nm. Hasil sebaran lapisan WS<sub>2</sub> di atas substrat PET lebih merata dibandingkan di atas substrat ITO/PET dan SiO<sub>2</sub>. Lapisan yang terbentuk memiliki ketebalan 12 nm di atas substrat PET dan 7 nm di atas substrat ITO/PET. Lapisan WS2 di atas substrat PET dan ITO/PET menyerap cahaya di sekitar panjang gelombang 600 – 650 nm dengan puncak serapan 600 nm. Karakterisasi sifat listrik dilakukan dengan cara mengamati kurva karakteristik I-V dari lapisan WS<sub>2</sub> di atas substrat PET dan SiO<sub>2</sub>. Nilai arus yang dihasilkan oleh lapisan WS<sub>2</sub> di atas substrat PET berkisar antara – 0,78 nA sampai 1,06 nA saat tegangan divariasi dari -10 V sampai 10 V dengan Vth = 4,037 V. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa resistivitas WS<sub>2</sub> bernilai 0,105 GΩ.μm. Nilai arus yang dihasilkan oleh lapisan WS<sub>2</sub> di atas substrat SiO<sub>2</sub> berkisar antara – 9,105 μA sampai 3,59 μA saat tegangan divariasi dari -5 V sampai 5 V dengan Vth = 3,03 V. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa resistivitas WS<sub>2</sub> bernilai 0,8 MΩ.μm. WS<sub>2</sub> di atas substrat ITO/PET tidak bisa dikarakterisasi sifat listriknya karena konduktivitas ITO/PET terlalu dominan.

**Kata kunci**: WS<sub>2</sub>, SiO<sub>2</sub>, PET, ITO/PET, Eksfoliasi, Sifat Listrik